

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2014-82316

(P2014-82316A)

(43) 公開日 平成26年5月8日(2014.5.8)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H O 1 L 27/12 (2006.01)	H O 1 L 27/12 B	
H O 1 L 21/02 (2006.01)	H O 1 L 21/285 Q	
H O 1 L 21/265 (2006.01)		

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号	特願2012-229111 (P2012-229111)	(71) 出願人	000190149
(22) 出願日	平成24年10月16日 (2012.10.16)		信越半導体株式会社
			東京都千代田区大手町二丁目6番2号
		(74) 代理人	100102532
			弁理士 好宮 幹夫
		(72) 発明者	曲 偉峰
			群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越
			半導体株式会社半導体磯部研究所内
		(72) 発明者	田原 史夫
			群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越
			半導体株式会社半導体磯部研究所内
		(72) 発明者	大井 裕喜
			群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越
			半導体株式会社半導体磯部研究所内

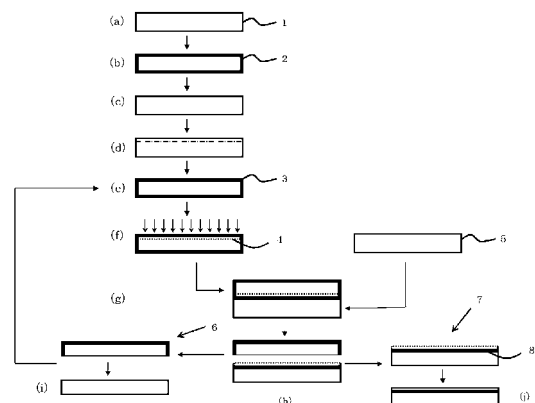
(54) 【発明の名称】 S O I ウェーハの製造方法

(57) 【要約】

【課題】S O I ウェーハの製造において、ボンドウェーハの欠陥を十分に消滅させて、欠陥等の不良のほとんどないS O I ウェーハを製造することができ、また、イオン注入剥離法において副産物として生成される剥離ウェーハをボンドウェーハとして何度も再利用することができるS O I ウェーハの製造方法を提供することを目的とする。

【解決手段】S O I ウェーハを製造する方法であって、酸化膜形成工程の前に、準備したシリコンウェーハに酸化性雰囲気下で1100 ~ 1250 の温度で30分 ~ 120分間の熱処理を施す工程、及び該熱処理後のシリコンウェーハの貼り合わせ面となる表面を研磨する工程を行うことを特徴とするS O I ウェーハの製造方法。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

チョクラルスキー法により育成されたシリコン単結晶インゴットから切り出されたシリコンウェーハをボンドウエーハとして準備する工程と、該準備したシリコンウェーハに酸化膜を形成する工程と、該酸化膜を形成したシリコンウェーハの貼り合わせ面となる表面から前記酸化膜を通してイオン注入を行って、前記シリコンウェーハ中にイオン注入層を形成する工程と、該イオン注入層を形成したシリコンウェーハとベースウェーハを貼り合わせて、前記シリコンウェーハを前記イオン注入層で剥離して剥離ウェーハとＳＯＩウェーハとに分離させる工程とを含むＳＯＩウェーハを製造する方法であって、

前記酸化膜形成工程の前に、前記準備したシリコンウェーハに酸化性雰囲気下で $1100 \sim 1250$ の温度で $30 \sim 120$ 分間の熱処理を施す工程、及び該熱処理後のシリコンウェーハの貼り合わせ面となる表面を研磨する工程を行うことを特徴とするＳＯＩウェーハの製造方法。

【請求項 2】

前記研磨工程において、前記熱処理後のシリコンウェーハに形成された酸化膜を除去した後、貼り合わせ面となる表面を $0.1 \sim 0.2 \mu\text{m}$ 研磨することを特徴とする請求項 1 に記載のＳＯＩウェーハの製造方法。

【請求項 3】

前記剥離ウェーハを、ＳＯＩウェーハの製造の際にボンドウエーハとして再利用することを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載のＳＯＩウェーハの製造方法。

【請求項 4】

前記準備するシリコンウェーハとして、初期酸素濃度が 14 ppm 以下のＮ領域（NPC）のウェーハ又は初期酸素濃度が 7 ppm 以下の窒素ドーブウェーハを用いることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか 1 項に記載のＳＯＩウェーハの製造方法。

【請求項 5】

前記窒素ドーブウェーハとして、窒素濃度が $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{15} \text{ atoms/cm}^3$ の窒素ドーブウェーハを用いることを特徴とする請求項 4 に記載のＳＯＩウェーハの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、イオン注入したウェーハを貼り合わせ後に剥離してＳＯＩ（Silicon on Insulator）ウェーハを製造する、いわゆるイオン注入剥離法（スマートカット（登録商標）法とも呼ばれている）によるＳＯＩウェーハの製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

ＳＯＩウェーハの製造方法としては、代表的なものにイオン注入剥離法がある。

このイオン注入剥離法を簡単に説明すると、まず、ボンドウエーハ及びベースウェーハとして、2枚のシリコンウェーハを準備し、少なくとも一方のシリコンウェーハ、例えばボンドウエーハにＳＯＩウェーハの埋め込み酸化膜となる酸化膜を形成した後に、該酸化膜を形成したシリコンウェーハの貼り合わせ面となる表面から前記酸化膜を通してイオン注入を行って、前記シリコンウェーハ中にイオン注入層を形成し、該イオン注入層を形成したシリコンウェーハとベースウェーハを貼り合わせて熱処理することによって、前記シリコンウェーハを前記イオン注入層で剥離して剥離ウェーハとＳＯＩウェーハとに分離させ、その後更に必要に応じて、結合熱処理を加えて強固に結合して、ＳＯＩウェーハを製造する方法である。

【0003】

デバイスプロセスの微細化に伴い、ＳＯＩウェーハのＳＯＩ層を形成するボンドウエーハは無欠陥化を要求されてきており、現状ではＳＯＩのボンドウエーハとして低酸素、低欠陥のＮ領域（NPC（Nearly Perfect Crystal））ウェーハを

10

20

30

40

50

使用している（特許文献１）。

【０００４】

しかし、このようなＣＯＰ（Crystal Originated Particle）フリーのNPCウェーハを使用しても、SOIウェーハの埋め込み酸化膜となる酸化膜を形成するため例えば９００で６時間の熱処理を施すと、SOI層となる表層に酸素析出核や酸素析出物（Bulk Micro Defect：BMD）等の酸素析出関連欠陥であるHF欠陥が発生する場合があります、特に、剥離ウェーハをボンドウエーハとして再利用した場合に、このような欠陥の発生が顕著であった。

【０００５】

このような欠陥を発生させないようにするため、剥離したN領域ウェーハにRTA処理を行い、表層の欠陥を消滅させてからボンドウエーハとして再利用する方法が行われてきた（特許文献２～４）。

しかし、このようなRTA処理はその都度行わなければならない、また何度もRTA処理を繰り返すとボンドウエーハが破損しやすくなるという問題があった。

【０００６】

このような再生処理におけるボンドウエーハの熱処理回数を減らすため、SOIウェーハを作製する前に、非酸化性雰囲気下等でボンドウエーハを熱処理する方法も行われている（特許文献５）。

しかし、このような方法であっても、再利用する前の検査で欠陥が確認された場合には、再度熱処理を行う必要があった。

【先行技術文献】

【特許文献】

【０００７】

【特許文献１】特開２００６－２９４７３７号公報

【特許文献２】特開２０１１－２３８７５８号公報

【特許文献３】特開２００８－０２１８９２号公報

【特許文献４】特開２００７－１４９９０７号公報

【特許文献５】特開２０１１－１７６２９３号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【０００８】

これらの問題を解決するためには、LST（Laser Scattering Tomography（赤外散乱トモグラフィ））で検出されるBMD密度が例えば $1 \times 10^7 / \text{cm}^3$ 未満のウェーハをボンドウエーハとして使用する必要がある。

また、SOIウェーハのコスト低減を実現するため、ボンドウエーハの再利用を考えると、バルクまで完全に無欠陥となるウェーハの作製技術の開発が必要である。

【０００９】

本発明は、上記問題に鑑みなされたものであって、SOIウェーハの製造において、ボンドウエーハの欠陥を十分に消滅させて、欠陥等の不良のほとんどないSOIウェーハを製造することができるSOIウェーハの製造方法を提供することを目的とする。また、イオン注入剥離法において副産物として生成される剥離ウェーハをボンドウエーハとして何度も再利用することができるSOIウェーハの製造方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【００１０】

上記課題を解決するため、本発明では、チョクラルスキー法により育成されたシリコン単結晶インゴットから切り出されたシリコンウェーハをボンドウエーハとして準備する工程と、該準備したシリコンウェーハに酸化膜を形成する工程と、該酸化膜を形成したシリコンウェーハの貼り合わせ面となる表面から前記酸化膜を通してイオン注入を行って、前記シリコンウェーハ中にイオン注入層を形成する工程と、該イオン注入層を形成したシリコンウェーハとベースウェーハを貼り合わせて、前記シリコンウェーハを前記イオン注入

10

20

30

40

50

層で剥離して剥離ウェーハとＳＯＩウェーハとに分離させる工程とを含むＳＯＩウェーハを製造する方法であって、

前記酸化膜形成工程の前に、前記準備したシリコンウェーハに酸化性雰囲気下で１１００～１２５０の温度で３０分～１２０分間の熱処理を施す工程、及び該熱処理後のシリコンウェーハの貼り合わせ面となる表面を研磨する工程を行うことを特徴とするＳＯＩウェーハの製造方法を提供する。

【００１１】

このような本発明のＳＯＩウェーハの製造方法によれば、ＳＯＩウェーハの製造において、ボンドウェーハの欠陥を十分に消滅させて、欠陥等の不良のほとんどないＳＯＩウェーハを製造することができる。また、イオン注入剥離法において副産物として生成される剥離ウェーハをボンドウェーハとして何度も再利用することができる。

10

【００１２】

ここで、前記研磨工程において、前記熱処理後のシリコンウェーハに形成された酸化膜を除去した後、貼り合わせ面となる表面を０．１～０．２μｍ研磨することが好ましい。

【００１３】

このように、酸化膜を除去してから貼り合わせ面となる表面を０．１～０．２μｍ研磨すれば、酸化性雰囲気下での熱処理で形成される酸化膜直下の欠陥を確実に除去することができる。

【００１４】

また、前記剥離ウェーハを、ＳＯＩウェーハの製造の際にボンドウェーハとして再利用することが好ましい。

20

【００１５】

本発明の製造方法で副生された剥離ウェーハは、本発明における酸化性雰囲気下での熱処理及び表面研磨により欠陥が十分に消滅しているため、これをボンドウェーハとして再利用すれば、生産性良く、低コストで高品質のＳＯＩウェーハを製造することができる。

【００１６】

また、前記準備するシリコンウェーハとして、初期酸素濃度が１４ppma以下のＮ領域（NPC）のウェーハ又は初期酸素濃度が７ppma以下の窒素ドーブウェーハを用いることが好ましい。

【００１７】

このようなウェーハを用いれば、ＳＯＩウェーハの製造工程の酸化熱処理（ＳＯＩウェーハの埋め込み酸化膜となる酸化膜を形成するための熱処理）を繰り返し行っても、HF欠陥が殆ど形成されることがない。

30

【００１８】

更に、前記窒素ドーブウェーハとして、窒素濃度が $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{15}$ atoms/cm³の窒素ドーブウェーハを用いることが好ましい。

【００１９】

このような窒素濃度の窒素ドーブウェーハを用いれば、本発明における酸化性雰囲気下での熱処理及び表面研磨により、バルク中までHF欠陥の原因となる酸素析出核や酸素析出物等を完全に消滅させることができる。

40

【発明の効果】

【００２０】

以上説明したように、本発明によれば、ボンドウェーハの酸素析出関連欠陥を十分に消滅させることができるため、HF欠陥の発生を抑制することができる。そのため、ＳＯＩウェーハの製造工程中の熱処理（ＳＯＩウェーハの埋め込み酸化膜となる酸化膜を形成するための熱処理）を行っても、HF欠陥が発生、成長しないボンドウェーハとすることができ、ＳＯＩ層に欠陥等の不良がほとんどなく、電気特性に優れた高品質のＳＯＩウェーハを効率的に製造することができる。また、イオン注入剥離法において副産物として生成される剥離ウェーハをボンドウェーハとして何度も再利用することができるため、コストを削減でき経済的である。

50

【図面の簡単な説明】

【0021】

【図1】本発明のSOIウェーハの製造方法の実施態様の一例を示すフロー図である。

【図2】実施例1、比較例1～3における再生回数別のHF欠陥密度を示すグラフである。

【図3】実施例2におけるHF欠陥密度を示すグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0022】

以下、本発明についてより詳細に説明する。

前述のように、従来SOIウェーハの製造においては、SOIウェーハ製造工程の酸化熱処理により中心部にHF欠陥が検出されることがあった。また、剥離したウェーハをボンドウェーハとして再利用する際には、その都度、又は少なくとも欠陥が確認された場合には熱処理を行い、表層の欠陥を消滅させる必要があった。

【0023】

そこで、本発明者らは、欠陥等の不良のほとんどないSOIウェーハを製造することができ、イオン注入剥離法において副産物として生成される剥離ウェーハをボンドウェーハとして再利用する際に、剥離ウェーハの表層の結晶欠陥を消滅させる熱処理を頻繁に行わなくとも、HF欠陥が形成されない条件を検討した。尚、HF欠陥とは、SOIウェーハをHF溶液に浸漬することで検出されるSOI層中の結晶欠陥の総称であり、SOI層を貫通する欠陥部分を通してHF溶液が埋め込み酸化膜層をエッチングしてできた空洞を検出するものである。

【0024】

その結果、埋め込み酸化膜となる酸化膜の形成工程前に、ボンドウェーハとして準備したシリコンウェーハに対し、前処理として酸素雰囲気下、1100～1250の温度で30分～120分間熱処理を施し、表面研磨を行うと、この最初の1回の熱処理（以下、便宜上「本発明の熱処理」ということもある）のみでSOIウェーハの製造工程の酸化熱処理を繰り返し行ってもHF欠陥が形成されないことを知見し、本発明を完成させた。

【0025】

以下、本発明について、実施態様の一例として、図を参照しながら詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

図1は、本発明のSOIウェーハの製造方法の実施態様の一例を示すフロー図である。

まず、本発明の製造方法では、ボンドウェーハ1として、チョクラルスキー法により育成されたシリコン単結晶インゴットから切り出されたシリコンウェーハを準備する（図1（a））。

【0026】

この準備するシリコンウェーハ（ボンドウェーハ1）としては、少なくとも一方の表面が鏡面研磨されたシリコンウェーハ等を挙げることができ、本発明においては、初期酸素濃度が14ppma（JEIDA）以下のN領域（NPC）のウェーハ又は初期酸素濃度が7ppma（JEIDA）以下の窒素ドーブウェーハを用いることが特に好ましい。

【0027】

このように、N領域（NPC）のウェーハは初期酸素濃度が14ppma（JEIDA）以下、窒素ドーブウェーハではN領域ウェーハでなくても初期酸素濃度が7ppma（JEIDA）以下であれば、SOIウェーハの製造工程の酸化熱処理を繰り返し行っても、当初本発明の熱処理をすることで、HF欠陥が形成されることが殆どない。

【0028】

特に、窒素ドーブすると低酸素濃度のウェーハでは欠陥サイズが小さくなり、N領域のウェーハでなくても上記熱処理によりバルク中までHF欠陥の原因となる酸素析出核や酸素析出物等を完全に消滅させることができる。

窒素ドーブウェーハを用いる場合には、窒素濃度が $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{15} \text{ atoms/cm}^3$ の窒素ドーブウェーハを用いることがより好ましい。

【 0 0 2 9 】

次に、前記準備したシリコンウェーハに酸化性雰囲気下で 1 1 0 0 ~ 1 2 5 0 の温度で 3 0 分 ~ 1 2 0 分間の熱処理を施す（図 1（b））。

酸化性雰囲気としては、酸素雰囲気や、酸素ガスと希ガス等の混合ガス（この場合、酸素ガスの含有率は 5 0 % を超えるものとする）を用いることができる。どのような雰囲気で熱処理するかは使用するボンドウェーハの特性に従い適宜選択すればよいが、効率よく欠陥を消滅させることができることから、酸素雰囲気（酸素ガス 1 0 0 %）が特に好ましい。

【 0 0 3 0 】

このような熱処理は、例えば抵抗加熱熱処理炉で行うことができる。

10

熱処理の際の温度は 1 1 0 0 ~ 1 2 5 0 、時間は 3 0 分 ~ 1 2 0 分間である。

【 0 0 3 1 】

このように、1 1 0 0 以上の高温で 3 0 分以上の熱処理を行えば、一度の熱処理でバルク中の酸素析出核及び酸素析出物等を完全に消滅させることができ、その後の剥離ウェーハをボンドウェーハとして再利用する工程において、表層の欠陥を消滅させるための熱処理をその都度行う必要はないので、工程の簡略化を実現することができる。

【 0 0 3 2 】

一方、1 2 5 0 を超える熱処理はボンドウェーハに負担となり、スリップ転位の発生や不純物汚染の問題が生じる。また、1 2 0 分程度熱処理を行えばバルク中の欠陥まで消滅させることができるため、熱処理による効果や効率等の観点から、熱処理は 1 2 5 0 以下で 1 2 0 分以下とする。

20

好ましくは、1 1 7 0 ~ 1 2 0 0 、6 0 分 ~ 1 2 0 分である。

【 0 0 3 3 】

このように、酸化性雰囲気下で 1 1 0 0 ~ 1 2 5 0 の温度で 3 0 分 ~ 1 2 0 分間の熱処理を施すと、熱処理により格子間シリコンが注入され、バルク中の空孔が対消滅して H F 欠陥の原因となる酸素析出核や酸素析出物等を減少させることができるので有効である。

【 0 0 3 4 】

一方、このような酸化性雰囲気下での熱処理を行うと、酸化によるバルク析出を消滅すると同時に、酸化膜直下の表層付近（厚さは熱処理温度及び基板酸素固溶度に依存する）は酸素の内方拡散に伴い、結晶欠陥が成長（C O P 内面酸化膜が厚くなり、空洞内面に酸化膜が形成され、B M D も成長）して、欠陥が顕在化する傾向がある。そのため、前記熱処理後に、シリコンウェーハの貼り合わせ面となる表面を研磨する工程（図 1（d））を行う必要がある。

30

【 0 0 3 5 】

このシリコンウェーハの貼り合わせ面となる表面の研磨代は、適宜決定することができるが、通常表面から 0 . 2 μ m 程度行えば十分であり、0 . 1 ~ 0 . 2 μ m の研磨代とすることがより好ましい。

【 0 0 3 6 】

尚、図 1（b）に示すように、本発明の熱処理により、酸化膜 2 が形成される場合もあるので、このような場合には、酸化膜 2 を除去した後（図 1（c））、図 1（d）の研磨を行っても良い。

40

酸化膜 2 の除去は、エッチング等により行うことができる。また、上述の研磨の際、先に酸化膜を研磨により除去してから、シリコンウェーハ（ボンドウェーハ 1）の貼り合わせ面の研磨を連続して行っても良い。

【 0 0 3 7 】

次に、シリコンウェーハ（ボンドウェーハ 1）に S O I ウェーハの埋め込み酸化膜 8 となる酸化膜 3 を形成する（図 1（e））。酸化膜 3 は、例えば 9 0 0 ~ 1 2 0 0 程度の温度で 5 ~ 6 時間熱処理を行うことにより、形成することができる。図 1（e）の場合は、シリコンウェーハ（ボンドウェーハ 1）の表面全体に酸化膜 3 が形成されているが、貼

50

り合わせ面のみに酸化膜 3 を形成しても良い。

【0038】

次に、該酸化膜 3 を形成したシリコンウェーハの貼り合わせ面となる表面から前記酸化膜 3 を通してイオン注入を行って、前記シリコンウェーハ中にイオン注入層 4 を形成する（図 1（f））。

イオン注入層 4 の深さは、イオン注入エネルギーにより決定される。従って、深く注入するためには大きな注入エネルギーが必要とされるが、通常の場合、酸化膜 3 表面から深くても 2 μm 程度であり、1 μm 以下の深さに注入することが多い。

【0039】

次に、該イオン注入層 4 を形成したシリコンウェーハ（ボンドウエーハ 1）とベースウェーハ 5（ベースウェーハ 5 としては、特に限定されず、例えばシリコンウェーハ等を準備することができる）を、酸化膜 3 を介して、前記イオン注入層 4 側を貼り合わせる（図 1（g））。その後、剥離のための熱処理を行うことによって、前記シリコンウェーハ（ボンドウエーハ 1）を前記イオン注入層 4 で剥離して剥離ウェーハ 6 と SOI ウェーハ 7 とに分離させる（図 1（h））。また、ボンドウエーハ 1 とベースウェーハ 5 とを貼り合わせる前に、どちらか一方又は両方のウェーハの貼り合わせ面にプラズマ処理を施して結合強度を高めることによって、剥離熱処理を省略し、機械的に剥離させることもできる。

【0040】

そして、必要に応じて、結合強度を高めるための結合熱処理や、分離した SOI ウェーハ 7 の表面を研磨等することで、欠陥のない SOI 層を有する SOI ウェーハを得ることができる（図 1（j））。

【0041】

また、上記のように本発明の製造方法で副生された剥離ウェーハ 6 を、他の SOI ウェーハの製造において、ボンドウエーハとして再利用することが好ましい。

【0042】

前述したように、本発明の熱処理及び表面研磨を行ったボンドウエーハは、酸素析出核や酸素析出物等が殆ど存在しておらず、即ち、1 μm 程度の SOI 層が剥離された後の剥離ウェーハであっても、酸素析出核、酸素析出物等が殆ど存在していない。従って、剥離ウェーハ 6 を少ない研磨代で研磨する（図 1（i））だけで、再びボンドウエーハとして使用することができるため、生産性良く低コストで SOI ウェーハを製造できる。

【0043】

剥離面を研磨するに際し、剥離面の研磨代は特に限定されないが、剥離面周辺部に形成されている段差とイオン注入層の歪を確実に除去し、結合不良の発生を十分に抑制するため、研磨代としては 3 μm 以上、好ましくは 5 μm より多く研磨することが望ましい。

【0044】

上記のように再生処理としての剥離面の研磨を行った剥離ウェーハ 6 をボンドウエーハとして、再度、図 1（e）～（g）の工程を行う。このように、本発明によれば、剥離ウェーハ 6 をボンドウエーハとして再利用する際に再度熱処理工程（b）を行わなくとも、HF 欠陥が生じることのない SOI ウェーハを製造することができる。これにより、低コストで高品質の SOI ウェーハを製造することができる。また、この SOI ウェーハ製造後の剥離ウェーハを再度上記の再生処理（研磨処理）を施して再利用する等、複数回再利用することもできる。

【実施例】

【0045】

以下、実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

（実施例 1、比較例 1～3）

抵抗加熱処理の効果の証明

直径 200 mm、N 領域（NPC）、初期酸素濃度 12 ppm のシリコンウェーハに、前処理なし（条件 1）、RTA（条件 2）、抵抗加熱処理（条件 3）、又は抵抗加熱処

10

20

30

40

50

理 + 研磨 (条件 4) を行った後、(1) 9 0 0 / 6 h r s の酸化熱処理を行い、(2) H F で酸化膜を除去 (擬似剥離) した後に、(3) K L A テンコール社製 S P 1 で 6 5 n m 以上の表面の H F 欠陥密度を測定し、(4) その後 5 μ m 研磨して、これを再生回数 0 回目とし、更に (1) ~ (4) を繰り返すことで擬似的にボンドウェーハの再利用工程を行い再生回数別の H F 欠陥密度を比較した。結果を図 2 に示す。

【 0 0 4 6 】

尚、(2) の「擬似剥離」とは、S O I ウェーハの製造工程にて行われる剥離工程 (ベースウェーハとの貼り合わせ + イオン注入層での剥離) を、(1) の酸化熱処理後にボンドウェーハの酸化膜を H F で除去する工程に置き換えたものであり、このように置き換えて評価しても、実際の S O I ウェーハの H F 欠陥密度を測定した結果と同様の傾向が得られることがわかっている。

【 0 0 4 7 】

(比較例 1)

条件 1 : N P C + 熱処理なし

(比較例 2)

条件 2 : N P C + R T A (A r 雰囲気、昇温速度 5 0 / 秒、最高温度 1 2 5 0 、保持時間 1 0 秒)

(比較例 3)

条件 3 : N P C + 抵抗加熱 (A r 雰囲気、1 2 0 0 、6 0 分)

(実施例 1)

条件 4 : N P C + 抵抗加熱 (酸素雰囲気、1 2 0 0 、6 0 分) + 0 . 1 μ m 表面研磨

【 0 0 4 8 】

図 2 に示すように、条件 1 の N P C + 熱処理なし (前処理として全く熱処理を行わなかった比較例 1) では、再生回数 0 回目より H F 欠陥が検出された。再生回数 2 回目までは問題ない程度であったものの、再生回数を増やすに従い H F 欠陥密度が増加した。条件 2 の N P C + R T A (前処理として R T A 処理を行った比較例 2) では、再生回数 4 回目より H F 欠陥が検出され、再生回数 5 回目までは問題ない程度であったものの、その後再生回数を増やすに従い H F 欠陥密度が増加した。条件 3 の N P C + 抵抗加熱 (前処理として A r 雰囲気下での熱処理を行った比較例 3) では、再生回数 1 回目より H F 欠陥が検出された。再生回数 3 回目までは問題ない程度であったものの、再生回数を増やすに従い H F 欠陥密度が増加した。

【 0 0 4 9 】

一方、条件 4 の N P C + 抵抗加熱 (前処理として酸素雰囲気下での熱処理及び 0 . 1 μ m 狙い表面研磨を行った実施例 1) では、再生回数を増やしても、H F 欠陥は殆ど検出されず、低いままの状態を保っていた。

【 0 0 5 0 】

(実施例 2)

窒素ドーブウェーハ及び N P C ウェーハの初期酸素濃度の違いによる効果の検証

直径 2 0 0 m m 、窒素濃度 5×10^{13} a t o m s / c m ³ 、初期酸素濃度 3 ~ 1 0 p p m a のウェーハ、及び直径 2 0 0 m m 、N 領域 (N P C) 、初期酸素濃度 3 ~ 1 7 p p m a のウェーハに、酸素雰囲気下で 1 2 0 0 、6 0 分間の熱処理を行い、その後、実施例 1 と同様に擬似的な再生方法を 5 回繰り返し、H F 欠陥密度を測定した。結果を図 3 に示す。

【 0 0 5 1 】

その結果、いずれのウェーハにおいても、H F 欠陥は問題ない程度であった。中でも、窒素ドーブウェーハでは初期酸素濃度が 7 p p m a 以下、N P C ウェーハでは初期酸素濃度が 1 4 p p m a 以下においては、H F 欠陥は殆ど検出されなかった。

【 0 0 5 2 】

(実施例 3)

S O I ウェーハの製造 1

ボンドウェーハとして、直径200mm、N領域(NPC)、初期酸素濃度12ppmaの鏡面研磨されたシリコンウェーハを準備し、ボンドウェーハの欠陥消滅のための熱処理を、酸素雰囲気中で1200、60分行った後、HFでエッチングして酸化膜を除去してから貼り合わせ面となる表面を0.1μm研磨した。そして、(i)900/6hrsの酸化熱処理を行って酸化膜を形成した後、(ii)この酸化膜を通して水素イオンを注入(注入条件は、加速電圧70keV、注入量 $6 \times 10^{16} / \text{cm}^2$ である)し、(iii)イオン注入したボンドウェーハを、ベースウェーハ(シリコンウェーハ)と室温で貼り合わせた後、500、30分の剥離熱処理を加えることにより、イオン注入層で剥離し、SOIウェーハを作製した。

【0053】

10

この際、SOIウェーハから分離した剥離ウェーハが副生された。この剥離ウェーハを用いて、上記(i)~(iii)を繰り返した。

再生回数5回目のHF欠陥を測定した結果、HF欠陥は問題のないレベルであった。

【0054】

また、得られたSOIウェーハも、SOI層に欠陥等の不良がなく、電気特性に優れた高品質のものであった。

【0055】

(実施例4)

SOIウェーハの製造2

ボンドウェーハとして、直径200mm、窒素ドーブ(窒素濃度 $5 \times 10^{13} \text{ atoms} / \text{cm}^3$)、初期酸素濃度6ppmaの鏡面研磨されたシリコンウェーハを準備した以外は、実施例3と同様にして、SOIウェーハを作製した。

20

【0056】

再生回数5回目のHF欠陥を測定した結果、HF欠陥は問題のないレベルであった。

また、得られたSOIウェーハは、SOI層に欠陥等の不良がなく、電気特性に優れた高品質のものであった。

【0057】

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。

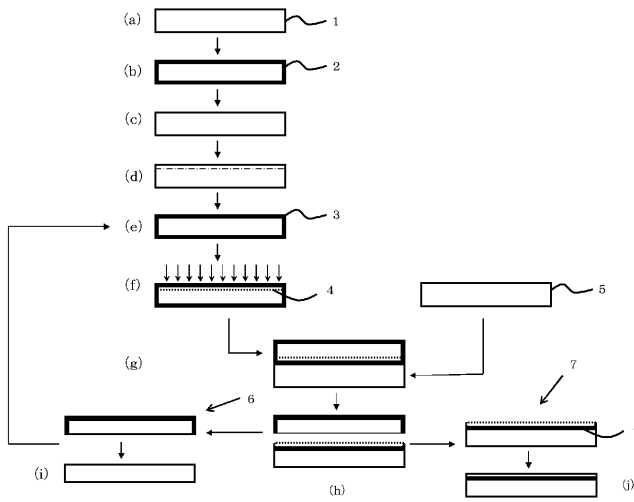
30

【符号の説明】

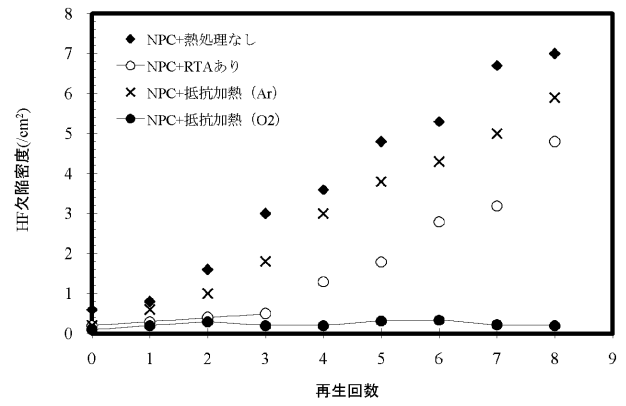
【0058】

1...ボンドウェーハ、 2、3...酸化膜、 4...イオン注入層、
5...ベースウェーハ、 6...剥離ウェーハ、 7...SOIウェーハ、
8...埋め込み酸化膜。

【図 1】



【図 2】



【図 3】

